

# 2SA957, 2SA958

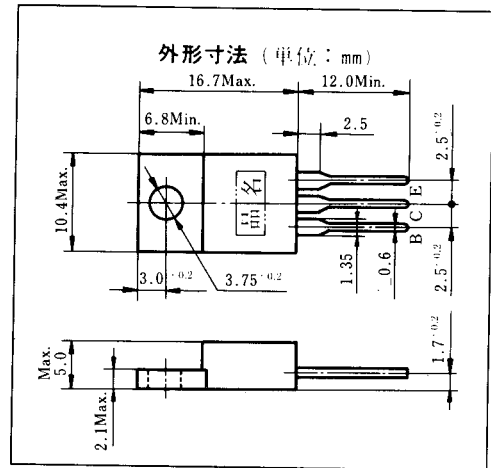
## ■シリコンPNPエピタキシャルメサ形トランジスタ

○一般用

☆レジジンモールドケース

### ■最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	2SA957	2SA958
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CB0</sub>	-150V	-200V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO</sub>	-150V	-200V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EB0</sub>	-6V	
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	-2A	
ベース電流	I <sub>B</sub>	-1A	
許容コレクタ損失	P <sub>C</sub>	30W (フランジ温度25°C)	
接合部温度	T <sub>j</sub>	150°C	
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55 ~ +150°C	



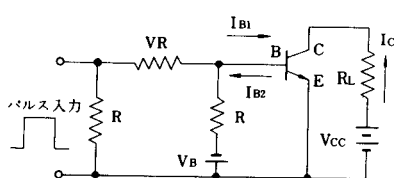
### ■電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	2SA957	2SA958
最大コレクタしゃ断電流	I <sub>CB0</sub>		-100 μA	-100 μA
		V <sub>CB</sub> =	-150V	-200V
最大エミッタしゃ断電流	I <sub>EB0</sub>	V <sub>EB</sub> = -6V	-1.0mA	
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> = -25mA	-150V	-200V
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> = -10V I <sub>C</sub> = -0.7A	40Min.	
コレクタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = -0.7A I <sub>B</sub> = -0.07A	-1.5V Max.	
しゃ断周波数	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> = -12V I <sub>E</sub> = 0.2A	20MHz Typ.	

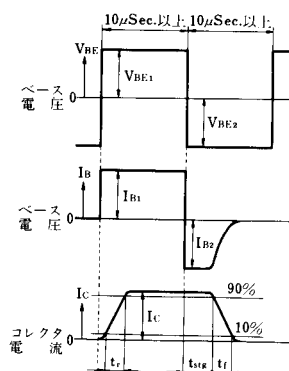
### ■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V <sub>CC</sub> (V)	R <sub>L</sub> (Ω)	I <sub>C</sub> (A)	I <sub>B1</sub> (mA)	I <sub>B2</sub> (mA)	t <sub>r</sub> (μSec.)	t <sub>stg</sub> (μSec.)	t <sub>f</sub> (μSec.)
-20	20	-1	-100	100	0.4	1.5	0.5

### スイッチング特性測定回路



### 測定条件



### 周囲温度と最大許容損失

